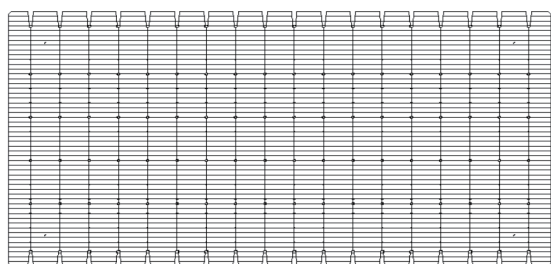


# 高效异质结电池

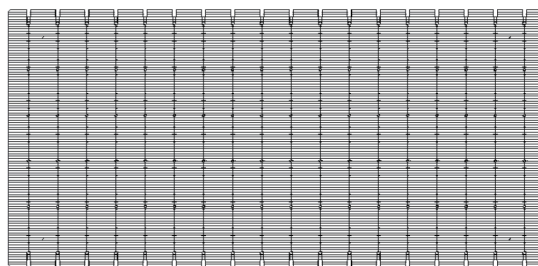
G12 | 210 半片双面

RHA-H02-02-18

## 电池片图形



正面



背面

## 产品优势



### 效率

平均效率26.1%以上



### 发电量

发电量增益5%以上



### 双面率

双面率达90%以上



### 工艺

4~6步工艺



### 污染

无氨氮废水产生



### 量产

可实现110um厚度硅片的量产应用



### 工艺温度

最高制程工艺温度不超过250°C



### 良率

平均生产良率达99%



### 无衰减

无PID, LID效应



### 温度系数

低温度系数

## I 主要电性能规格参数

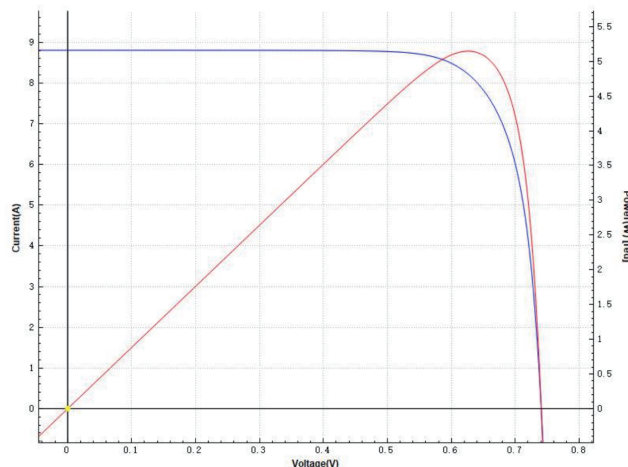
效率	功率	开路电压	短路电流	填充因子	最大功率点电压	最大功率点电流
Eff (%)	Pmpp(W)	Uoc(V)	Isc (A)	FF (%)	Umpp(V)	Impp(A)
26.30	5.79	0.753	8.839	86.99	0.684	8.465
26.20	5.77	0.753	8.823	86.85	0.683	8.448
26.10	5.75	0.752	8.817	86.79	0.682	8.438
26.00	5.73	0.752	8.806	86.57	0.682	8.405
25.90	5.71	0.751	8.797	86.44	0.681	8.385
25.80	5.69	0.751	8.772	86.35	0.680	8.365
25.70	5.67	0.750	8.748	86.36	0.679	8.345
25.60	5.64	0.750	8.730	86.21	0.679	8.313
25.50	5.62	0.749	8.719	86.09	0.678	8.292
25.40	5.60	0.749	8.687	86.07	0.678	8.260
25.30	5.58	0.748	8.672	85.99	0.677	8.240
25.20	5.56	0.748	8.658	85.79	0.676	8.219
25.10	5.53	0.748	8.631	84.72	0.675	8.199
25.00	5.51	0.747	8.623	84.57	0.674	8.178

标准测试条件: 1000W/m<sup>2</sup>, AM1.5, 25°C; 以上技术参数受限于技术变更及测试。

## II 温度系数

Voc (%/°C)	~-0.27%/°C
Isc (%/°C)	~0.055%/°C
Pm (%/°C)	~-0.26%/°C

## III I-V特性曲线



## IV 产品规格

尺寸	210 mm*105 mm±0.25 mm
基底材料	n型单晶硅
厚度	110 -10/+20 μm
正面(-)	18 主栅线(银), 蓝色透明导电膜(TCO)
背面(+)	18 主栅线(银), 蓝色透明导电膜(TCO)

## V 包装信息

数量	24包/箱, 140片/包, 3360片/箱
尺寸	60cm*30cm*30.5cm